

a 2007 0334

Invenția se referă la un procedeu de obținere a peliculelor subțiri de semiconductoare oxidice, în particular de In_2O_3 . Procedeu include depunerea peliculelor prin piroliză spray la temperatura de 450...550°C din soluții apoase de InCl_3 cu concentrația sării de metal din soluție ce depășește 0,2M cu recoacerea ulterioară în atmosferă neutră sau cu conținut de oxigen la o temperatură nu mai mică de 1000°C.

Rezultatul invenției constă în obținerea peliculelor cu textură înaltă în direcția (100) cu grosimea de 200...3000 nm cu dimensiuni mari ale suprafeței cristalografice plate a cristalitelor.

Revendicări: 1

Figuri: 3